

Официальный оппонент **Егоров Антон Юрьевич**, член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н., профессор кафедры «физики и технологии наногетероструктур» Федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального образования и науки Санкт-Петербургский Академический университет - научно-образовательный центр нанотехнологий РАН, г. Санкт-Петербург, anton@beam.ioffe.ru

Список основных публикаций:

1. Kaliteevski M.A., Brand S., Abram R.A., Chamberlain J.M., Sasin M.E., Seisyan R.P., Iorsh I.V., Egorov A.Yu., Vasil'ev A.P., Kavokin A.V., Shelykh I.A., Mikhlin V.S. Tamm Plasmon-Polaritons: First Experimental Observation //Superlattices and Microstructures. 2010. Т. 47. № 1. С. 44-49.
2. A. O. Zakhar'in, A. V. Andrianov, A. Yu. Egorov, N. N. Zinov'ev Terahertz Photoluminescence from GaAs Doped with Shallow Donors at Interband Excitation //Applied Physics Letters. 2010. Т. 96. № 21. С. 211118-3.
3. Жуков А.Е., Крыжановская Н.В., Максимов М.В., Егоров А.Ю., Павлов М.М., Зубов Ф.И., Асрян Л.В. Полупроводниковый лазер с асимметричными барьерными слоями: высокая температурная стабильность //Физика и техника полупроводников. 2011. Т. 45. № 4. С. 540-546.
4. Расулова Г.К., Брунков П.Н., Пентин И.В., Ковалюк В.В., Горшков К.Н., Казаков А.Ю., Иванов С.Ю., Егоров А.Ю., Саксеев Д.А., Конников С.Г. Взаимная синхронизация двух связанных генераторов автоколебаний на основе сверхрешеток GaAs/AlGaAs //Журнал технической физики. 2011. Т. 81. № 6. С. 80-84.
5. Asryan L.V., Kryzhanovskaya N.V., Maximov M.V., Egorov A.Y., Zhukov A.E. Bandedge-Engineered Quantum Well Laser//Semiconductor Science and Technology. 2011. Т. 26. № 5. С. 055025.
6. Чалдышев В.В., Кунделев Е.В., Никитина Е.В., Егоров А.Ю., Горбацевич А.А. Резонансное отражение света периодической системой экситонов в квантовых ямах GaAs/AlGaAs //Физика и техника полупроводников. 2012. Т. 46. № 8. С. 1039-1042.
7. Буяло М.С., Горбацевич А.А., Егоров А.Ю., Гаджиев И.М., Бакшаев И.О., Задиранов Ю.М., Ильинская Н.Д., Портной Е.Л. влияние ширины барьера в структуре с двумя асимметричными связанными квантовыми ямами на область существования пассивной синхронизации мод //Письма в Журнал технической физики. 2012. Т. 38. № 7. С. 31-39.

8. Блохин С.А., Бобров М.А., Малеев Н.А., Кузьменков А.Г., Стеценко В.В., Павлов М.М., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Задиранов Ю.М., Егоров А.Ю., Устинов В.М. Влияние оптических потерь на динамические характеристики линейных матричных излучателей на основе вертикально-излучающих лазеров ближнего инфракрасного диапазона //Физика и техника полупроводников. 2013. Т. 47. № 6. С. 833-837.
9. Бабичев А.В., Лазаренко А.А., Никитина Е.В., Пирогов Е.В., Соболев М.С., Егоров А.Ю. Сверхширокий спектр электролюминесценции светодиодных гетероструктур на основе полупроводниковых твердых растворов GaPAsN //Физика и техника полупроводников. 2014. Т. 48. № 4. С. 518-522.
10. Кудряшов Д.А., Гудовских А.С., Никитина Е.В., Егоров А.Ю. Разработка конструкции многопереходных солнечных элементов на основе гетероструктур GaPNAs/Si методом компьютерного моделирования //Физика и техника полупроводников. 2014. Т. 48. № 3. С. 396-401.